

CMKDM8005

**SURFACE MOUNT SILICON
DUAL P-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
MOSFET**



SOT-363 CASE

APPLICATIONS:

- Load switch/Level shifting
- Battery charging
- Boost switch
- Electro-luminescent backlighting

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

Drain-Source Voltage
Gate-Source Voltage
Continuous Drain Current (Steady State)
Continuous Source Current (Body Diode)
Maximum Pulsed Drain Current
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMKDM8005 consists of dual P-Channel enhancement-mode silicon MOSFETs designed for high speed pulsed amplifier and driver applications. These MOSFETs offer very low $r_{DS(ON)}$ and low threshold voltage.

MARKING CODE: C85M

FEATURES:

- ESD protection up to 1800V (Human Body Model)
- 350mW power dissipation
- Very low $r_{DS(ON)}$
- Low threshold voltage
- Logic level compatible
- Small, SOT-363 surface mount package

SYMBOL		UNITS
V_{DS}	20	V
V_{GS}	8.0	V
I_D	650	mA
I_S	250	mA
I_{DM}	1.0	A
P_D	350	mW
T_J, T_{stg}	-65 to +150	$^{\circ}\text{C}$
Θ_{JA}	357	$^{\circ}\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER TRANSISTOR: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_{GSSF}, I_{GSSR}	$V_{GS}=4.5\text{V}, V_{DS}=0$			10	μA
I_{DSS}	$V_{DS}=16\text{V}, V_{GS}=0$			100	nA
BV_{DSS}	$V_{GS}=0, I_D=250\mu\text{A}$	20			V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu\text{A}$	0.5		1.0	V
V_{SD}	$V_{GS}=0, I_S=250\text{mA}$			1.1	V
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=4.5\text{V}, I_D=350\text{mA}$		0.25	0.36	Ω
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=2.5\text{V}, I_D=300\text{mA}$		0.37	0.5	Ω
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=1.8\text{V}, I_D=150\text{mA}$			0.8	Ω
g_{FS}	$V_{DS}=10\text{V}, I_D=200\text{mA}$	0.2			S
C_{rss}	$V_{DS}=16\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$		25		pF
C_{iss}	$V_{DS}=16\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$		100		pF
C_{oss}	$V_{DS}=16\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$		21		pF

R3 (3-June 2013)

CMKDM8005

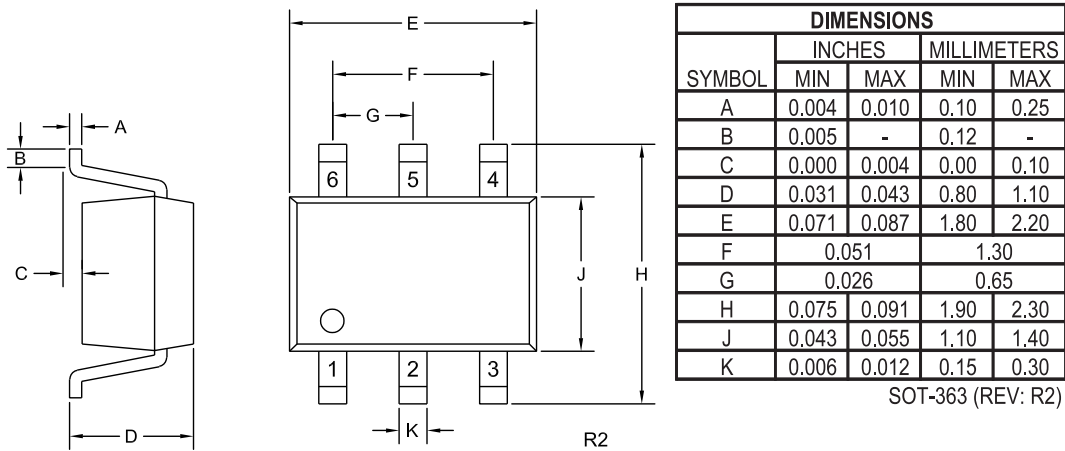
**SURFACE MOUNT SILICON
DUAL P-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
MOSFET**



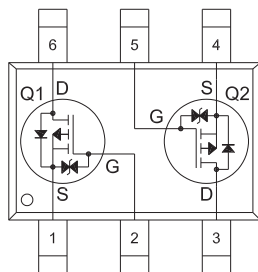
ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER TRANSISTOR - Continued: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	TYP	MAX	UNITS
$Q_{g(\text{tot})}$	$V_{DS}=10\text{V}$, $V_{GS}=4.5\text{V}$, $I_D=200\text{mA}$	1.2		nC
Q_{gs}	$V_{DS}=10\text{V}$, $V_{GS}=4.5\text{V}$, $I_D=200\text{mA}$	0.24		nC
Q_{gd}	$V_{DS}=10\text{V}$, $V_{GS}=4.5\text{V}$, $I_D=200\text{mA}$	0.36		nC
t_{on}	$V_{DD}=10\text{V}$, $V_{GS}=4.5\text{V}$, $I_D=200\text{mA}$, $R_G=10\Omega$	38		ns
t_{off}	$V_{DD}=10\text{V}$, $V_{GS}=4.5\text{V}$, $I_D=200\text{mA}$, $R_G=10\Omega$	48		ns

SOT-363 CASE - MECHANICAL OUTLINE



PIN CONFIGURATION



LEAD CODE:

- 1) Source Q1
- 2) Gate Q1
- 3) Drain Q2
- 4) Source Q2
- 5) Gate Q2
- 6) Drain Q1

MARKING CODE: C85M

R3 (3-June 2013)

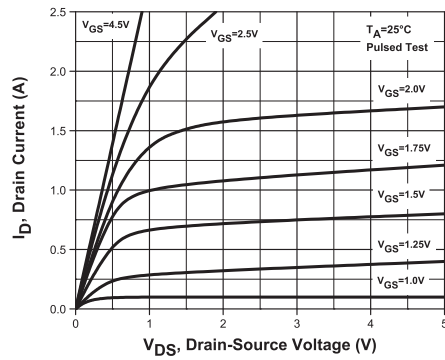
CMKDM8005

**SURFACE MOUNT SILICON
DUAL P-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
MOSFET**

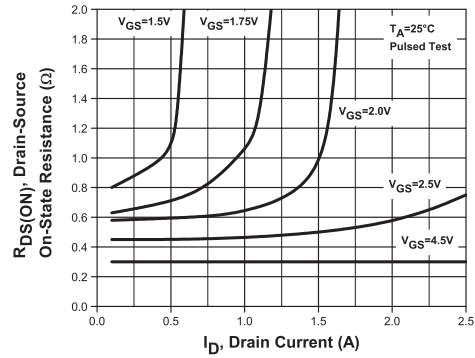


TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

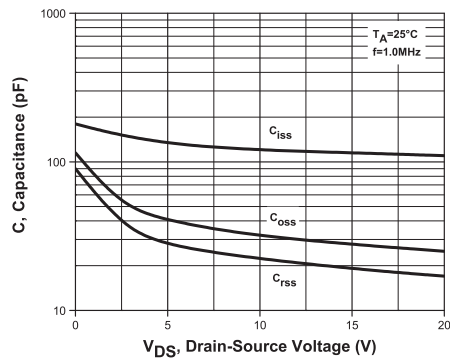
Output Characteristics



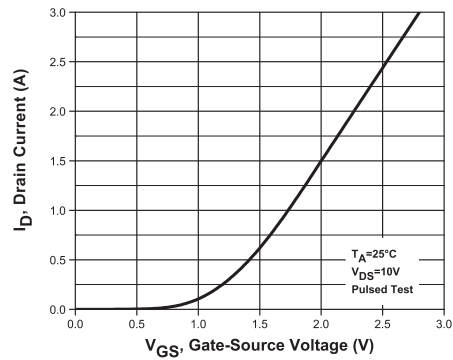
Drain Source On Resistance



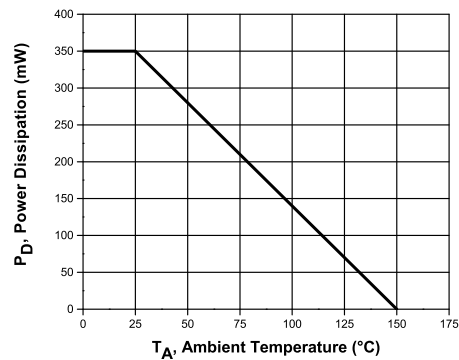
Capacitance



Transfer Characteristics



Power Derating



R3 (3-June 2013)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9